

# 内存超级周期—— DRAM/HBM 定价权与卡点传导

## 内存超级周期——DRAM/HBM 定价权与卡点传导

内存是 AI 这一轮超级周期里最确定、也最先兑现的结构性卡点；原厂的 flow 已巨幅计入股价、属追高区，真正未被定价的卡位在 base die 逻辑化后外溢的接口 IP/定制基底/内存互连，最纯的补涨是接口 IP，最大反证是 DRAM 涨价二阶导转负叠加 AI capex 边际放缓。

**封面命题：**当 AI 算力的瓶颈从「能不能算」转向「喂不喂得饱」，内存成为这一轮超级周期里最确定、也最先兑现的结构性卡点。但「确定」不等于「便宜」——原厂这一段的价格爆发已大幅计入股价，真正的错位在卡点向下游传导时溢出的设计/IP 价值，以及下一代技术（HBM4/HBF/LPDDR 进数据中心）尚未被定价的卡位。本报告以 flow vs value 为主轴，拆解定价权的来源、兑现节奏与传导路径。

## 一、30秒结论卡

**一句话判断：**内存是 AI 超级周期里四特征全绿的高纯度真瓶颈，但原厂的价格爆发已被巨幅定价——真 alpha 不在「贵不贵」，而在「周期在哪一端」与「卡点传导到哪一层还没被定价」。当前是兑现窗口与布局观察期，不是追高期。

### 维度 结论

机会状态	原厂（MU/海力士/三星）● 拥挤·持有不追 · 接口 IP（RMBS）● 甜蜜·相对未透支 · 定制基底/互连态（MRVL/ALAB）● 远期期权 · 远期 HBF ● 待验证
市场错在哪	把「确定」当「便宜」、把低 PE 当便宜（强周期股低 PE 是顶部信号）、忽略 1Q26 标准 DRAM 单位晶圆利润已反超 HBM 的利润倒挂
重点标的	RMBS（最纯补涨卡位）· MU（美股唯一纯正原厂·持有不追）· MRVL/ALAB（传导层期权·兑现在 2027）
最大反证	DRAM 涨价二阶导已转负（1Q26 约 +90% → 2Q26 +58~63%）；若叠加 AI capex 边际放缓，内存作为强周期股回撤最猛

## 二、投资要点

**一句话框架：**内存是「今天就在流钱」的真瓶颈（flow 与 value 双实），但原厂的 flow 已被充分定价；真正的补涨错位在 base die 逻辑化后溢出的设计/IP 价值，以及 2027 长协重定价才全额兑现的 HBM 利润弹性。

#	核心观点	方向
1	内存是四特征全绿的高纯度真瓶颈：供需失衡、认证壁垒、卖方定价权、AI 主驱动	● 利好
2	HBM 挤占标准 DRAM 产能（晶圆换算约 3:1、趋向 4:1），把 HBM 紧缺传导成全品类 DRAM 紧缺，常规 DRAM 合约价 1Q26 QoQ 约 +90%	● 利好
3	原厂（MU/海力士/三星/SNDK）52 周涨幅 +500%~+5,300%，叙事已巨幅兑现到价——属追高区，非新建仓位区	● 承压
4	HBM4 起 base die 逻辑化，价值量从原厂外溢到接口 IP/定制基底/内存互连，接口 IP（RMBS）是最纯、兑现最快的补涨卡位	● 利好
5	强周期股「低 PE = 周期顶信号」悖论：海力士 PE 6.7 / 三星 6.1 不是便宜，而是市场提前定价下行	● 中性
6	周期见顶信号已现：DRAM 涨价二阶导转负、NAND 链 2027 Q3 见顶时点最明确	● 风险

### 三、钱流：价格爆发与供给约束

#### 3.1 涨价数据（逐项标注季度/品类）

指标	数值	口径	状态
常规 DRAM 合约价 1Q26	QoQ 约 +90%（区间 +90~98%）	常规 DRAM·合约·QoQ	●
常规 DRAM 合约价 2Q26	QoQ +58~63%（mobile DRAM 领涨）	常规 DRAM·合约·QoQ	●
服务器 DRAM 合约价 1Q26	QoQ +55~70%	服务器子品类·合约·QoQ	●
DDR5 模组现货 16GB	2025-09 <\$10 → 2026 年中约 \$30	16GB 单品·现货	●
DDR5 模组合约 32GB	三星 \$149 → \$239（+60%）	32GB 单品·合约	●
现货价整体	温和上涨、买盘谨慎，弱于合约（DDR4 部分品类 2Q26 已小幅回落）	现货	●

本轮是价格爆发主导的周期，最反直觉的信号是常规 DRAM 涨幅一度超过 HBM——AI 占用产能挤出常规 DRAM 供给，反而让 DDR5 价格弹性最大。这意味着主题股普涨阶段，真 alpha 在「卖方定价权能兑现到毛利」的标的，而非单纯的容量 beta。

### 3.2 利润倒挂——本轮最大认知差

1Q26 起，DDR5 RDIMM 单晶圆产值与毛利反超 HBM3e：HBM 受年度定价机制锁定，而 DDR5 现货/合约暴涨，导致 HBM 单晶圆利润一度跌破 DDR5。这驱动厂商在 2027 HBM 合约谈判（2Q26 启动）中强推涨价。市场叙事「HBM = 最肥的肉」与 1Q26 实证背离——HBM 利润短期被年度定价封顶，标准 DRAM 反而更赚；HBM 的大头利润弹性要等 2027 长协重定价才全额兑现。这是 flow vs value 里「今天 vs 未来」的典型错位。

### 3.3 供给约束与定价权机制

- **供给收紧**：2026 DRAM bit 供给增长仅 +10~15%（投资集中于制程升级与混合键合，非净增 wafer），AI（含 HBM/GDDR7）独占约 20% 全球 DRAM wafer 产能。HBM3/HBM3e 多数节点已售罄至 2026 年底，三星、美光均宣告 2026 HBM 供应售罄。
- **扩产节奏**：三星 2026 年内将 1c DRAM（10nm 级第 6 代）投片产能扩至 20 万片/月（投片口径），约占其 DRAM 总产能（65~70 万片/月）的 1/3，规模空前于 2022 周期的 13 万片新增；1c 是 HBM4 base die 的基础节点。
- **机制升级**：2026 Q2 起，三星与海力士将大客户从一年期短约切换为 3~5 年 LTA-only 模式；海力士 LTA 含最低价格地板（price floor）等下行保护——卖方锁住下行、保留上行。海力士/美光 2026 全年（含 HBM4）产能售罄。2027 HBM 合约价预期翻数倍，三家握绝对定价权。

### 3.4 HBM4 量产时间线

时点	事件
2025-09	海力士 HBM4 量产体系就位；三星交付工程样片
2026-02	三星 HBM4 通过最终验证，开始量产出货（供 Rubin）
2026-06-05	海力士通过 NVIDIA Vera Rubin HBM4 认证
2026 Q3	海力士 HBM4 量产；美光 HBM4（供 Vera Rubin）进入量产
2026 Q4	NVIDIA 要求交付 16-Hi HBM4
2027	HBM4E（含 3nm 级定制 base die）+ 2027 HBM 长协重定价

## 四、价值链 5 层图与受益链：卡点向下游传导的物理学

HBM4 的关键结构变化：逻辑基底（base die）首次改用先进逻辑代工工艺（海力士走 TSMC 3nm 级、三星走自家 4nm 级，HBM4E 三星推进至 2nm），不再用传统 DRAM 工艺。这把「内存」变成了「内存 + 逻辑芯片」的混合体——价值量与设计权从原厂部分外溢到接口 IP / 定制基底 / 内存互连三个环节。这是本轮传导链的物理底层，也是「卖铲子下沉」的机会所在。

需求源 一级供应商 真卡口 可投代理 已拥挤 / 未定价

NVIDIA / AMD → 原厂 base die 逻辑化 → RMBS 接口 IP → 原厂(MU/海力士/

超大厂 capex (MU/海力士/三星) (内存+逻辑混合) MRVL 定制基底 三星)=已拥挤

ALAB 内存互连 接口 IP=未充分定价

TSMC base die 代工



传导层	价值溢出方向	代表标的	状态
接口 IP / 主控	HBM4 控制器/PHY IP 价值量随基底逻辑化上移; MRDIMM 接口芯片含量倍增 (1 RCD → 1 MRCD+10 MDB)	RMBS	●
定制 HBM 基底	原厂 base die 变为第三方设计的定制基底	MRVL	●
内存互连 / CXL	推理「内存墙」驱动 KV Cache offload / 内存池化	ALAB	●
base die 逻辑代工	TSMC 承接 HBM4 base die, 逻辑化新增价值	TSMC	●

## 五、卡点四象限：真瓶颈四特征评分

特征	判定	证据
①结构性供需失衡	● 强成立	HBM 占 DRAM 晶圆 18%→22%→30% (25/26/27); 三家 2026 全售罄, 缺货延至 2028
②替代难 (认证周期)	● 强成立	HBM NVIDIA 认证 12-18 月; 晶圆换算 3:1→4:1 物理不可逆; 新厂 18-24 月
③定价权在卖方	● 成立 (有时滞)	标准 DRAM QoQ +90% 已兑现; HBM 因年度定价滞后, 2027 长协重定价全额兑现; LTA 含 price floor 偏卖方
④AI 增量是主驱动	● 强成立	美光 DRAM 收入 +207% YoY、海力士营收 +198% YoY, 全部 AI/HBM 拉动

**四象限定位：**原厂 = 真卡点但已拥挤 (proxy/持有不追) · 接口 IP (RMBS) = 真卡点且可投 (核心补涨) · 模组厂 = 非卡点 (无定价权·回避) · 远期 HBM = 真卡点待验证 (监控)。内存三寡头是 AI 超级周期中卡点纯度最高的环节之一 (四条全绿, 仅③有时间滞后)。

## 六、7 行公司卡

### RMBS (Rambus) — ● 布局观察

- 位置：L2·内存接口 IP，HBM4E 控制器 + MRDIMM 双引擎
- 卡口：base die 逻辑化把控制器/PHY IP 价值量上移；MRDIMM 把单模组接口芯片含量从 1 RCD 升到 1 MRCD+10 MDB
- 为何被低估：52 周 +140% 为全组最温和，IP 收租模式周期免疫度相对高
- 证据：Q1 FY26 总营收 \$180.2M (产品 \$88.0M, YoY +15%)，80% 级毛利、份额稳 (退出 2025 约 mid-40%)；2026-03 发布业界最快 HBM4E 控制器 IP (16 Gbps/pin、4.1 TB/s)
- 估值口径：现价 \$141.17 / PE 67.2 / 市值 \$15.3B (2026-06-21 实时)
- 催化 (3/6/12 月)：HBM4E 控制器 IP 客户签约 / MRDIMM 放量 / 2027 数据中心 DDR5→MRDIMM 迁移
- 反证：若 HBM4 base die 设计权更多被原厂自留、第三方 IP 渗透不及预期

### MU (美光) — ● 持有不追

- 位置：L2·HBM 核心，HBM4+SOCAMM2 双卡位，美股唯一纯正原厂受益
- 卡口：HBM4 供 Vera Rubin；LPDDR 进数据中心 (SOCAMM) 直接受益
- 为何被低估：盈利爆发真实但 52 周 +996.9% 后弹性透支
- 证据：FY26 Q2 营收 \$23.86B (YoY +196%、QoQ +75%)，毛利率 74.9% (公司纪录)，DRAM 收入 \$18.8B (占 79%)；FY3Q26 指引营收 \$33.5B±0.75、毛利率约 81%；2026 HBM 产能全部售罄
- 估值口径：现价 \$1,133.99 / PE 53.5 / 市值 \$1,278.8B (2026-06-21 实时)
- 催化：FY3Q26 业绩兑现 / HBM4 量产 / SOCAMM 放量
- 反证：DRAM 涨价二阶导转负 + AI capex 边际放缓，强周期股回撤最猛

### MRVL (Marvell) — ● 远期期权

- 位置：L2·定制 HBM 基底 + 定制 ASIC
- 卡口：Custom HBM 架构 (内存容量 +33%、I/O 功耗 -70%、释放 25% 硅面积)
- 为何被低估/高估：custom HBM 属 FY27-29 期权，当下营收由定制 XPU/互连驱动，估值已部分透支远期
- 证据：Q1 FY27 营收 \$2.418B (YoY +28%)，数据中心 \$1.83B (占 76%)
- 估值口径：现价 \$310.58 / PE 106.4 / 市值 \$271.7B (2026-06-21 实时)
- 催化：custom HBM 客户落地 / 定制 XPU 放量
- 反证：custom HBM 兑现晚于预期、定制 ASIC 竞争加剧

### ALAB (Aster Labs) — ● 高赔率高估值

- 位置：L2·内存互连 CXL/PCIe
- 卡口：Leo CXL 内存扩展 (KV Cache offload 实测 3.6x 内存扩展、GPU 利用率 +75%)

- 为何高估：CXL 内存池化兑现在 2027，当前主营收仍是 Scorpio 交换/Aries retimer，PE 285.7 把远期全折现
- 证据：Q1 FY26 营收 \$308.4M (YoY +93%)
- 估值口径：现价 \$417.07 / PE 285.7 / 市值 \$71.5B (2026-06-21 实时)
- 催化：Leo CXL 量产 / 推理内存墙驱动池化需求
- 反证：CXL 落地慢于预期、估值对利空敏感

## 七、格局与分化：座次相反的两个寡头

### DRAM 收入市占 (2026 自然 Q1, Omdia/TrendForce/Counterpoint 三源交叉)

口径提示：本表为第三方机构追踪的**自然季 (1-3 月) DRAM 子项口径**，与各公司财年季 IR 数不同步——故美光此处 DRAM \$21.7B (自然 Q1) 与 §A2 美光 FY26Q2 (截至 2026-02) DRAM \$18.8B 为两套口径，不可直接相减。

#	厂商	收入市占	营收绝对值	QoQ 变化
1	三星	38.6%	\$37.4B (+95.4% YoY)	从 Q4 的 36.5% 回升 +2.1pct, 重夺第一
2	海力士	28.8%	\$28.0B	从 32.9% 下滑, 退居第二
3	美光	22.4%	\$21.7B	从 22.8% 微降

全行业 DRAM 收入 +85.3% YoY。HBM 子市场座次相反：HBM 整体海力士约 55~62% (出货口径)，美光 2026 反超三星升第二，三星回补；HBM4 (Rubin 平台) 份额预期海力士 60~70% / 三星 25~30% / 美光约 20% (NVIDIA 2026 HBM4 供应商口径)。

标准 DRAM 与 HBM 都是真寡头，但内部座次相反——海力士靠 HBM 吃利润，三星靠标准 DRAM 体量守收入第一，美光 HBM 已超三星升第二。HBM 端海力士有定价主导，标准 DRAM 端三家共同收紧。三个口径 (DRAM 收入第一是三星、HBM 第一是海力士、美光 HBM 第二) 不可混用。

## 八、情景与受益标的表 (按 flow/value 分层)

核心决策标的见下表，完整 9 标的名单 (含 SNDK/WDC/STX/TSM) 见附录。三种情景：基准 = 周期延续至 2027 长协重定价、原厂持有不追/RMBS 补涨；熊 = DRAM 二阶导转负 + capex 失速、全组减仓；牛 = 缺货延至 2028 + HBM4E 提价超预期、RMBS 与原厂同步重估。

#	代码	现价	PE	52w 涨幅	卡点定位	评级
1	RMBS	\$141.17	67.2	+140.0%	内存接口 IP, HBM4E 控制器+MRDIMM 双引擎, 最纯补涨	🟢 布局观察
2	MU	\$1,133.99	53.5	+996.9%	HBM 核心, 美股唯一纯正原厂, HBM4+SOCAMM2 双卡位	🟡 持有不追
3	海力士 000660.KS	₩2,764,000	6.7	+1,028.2%	HBM 全球第一, MR-MUF 技术壁垒	🟡 持有不追
4	三星 005930.KS	₩354,000	6.1	+514.6%	HBM4 追赶者, 份额回升弹性	🟡 中性
5	MRVL	\$310.58	106.4	+405.5%	定制 HBM 基底 + 定制 ASIC, custom HBM 属 FY27-29 期权	🟡 远期期权
6	ALAB	\$417.07	285.7	+391.9%	内存互连 CXL/PCIe, KV Cache 卡位兑现在 2027	🟡 高赔率高估值

### 分层结论:

- 🟢 布局观察区 (卡位硬、相对未透支): RMBS——IP 收租、52 周 +140% 全组最温和、80% 毛利、HBM4E 控制器+MRDIMM 双引擎、周期免疫力相对高, 是最纯的补涨卡位。
- 🟡 中性核心 (真瓶颈但充分定价, 持有不追): MU / 海力士——四特征全中、盈利爆发真实, 但 +1,000% 后属「持有/回调加仓」非「新建追高」。
- 🔴 追高区 (叙事已兑现到价, 回避追涨): SNDK (52 周 +5,348%, 含 2024 分拆/低基数, 弹性透支最深) · WDC (+1,172%, 涨幅领先盈利) · ALAB (PE 285.7 把远期全折现)。详见附录。

下一代变量: LPDDR 进数据中心 (SOCAMM) 2026 已落地, 是被低估的新供给瓶颈, MU 直接受益; HBF (SNDK+海力士) 样品 2H26、放量约 2030, 属高赔率高风险远期题材, 现价不追 (🟡 待验证)。

## 九、风险与反证 (反证信号)

每条写明「什么条件出现 = 证明本报告结论错」。

#	反证信号（出现即结论需重写）	性质	评级
1	DRAM 涨价二阶导持续转负：1Q26 约 +90% → 2Q26 +58~63%，若 3Q26 进一步收敛甚至转平	周期见顶	●
2	NAND 价格在 2027 Q3 前提前见顶（YMTC 增量转 DRAM），NAND 链先到峰值	周期见顶	●
3	海力士 6.7 / 三星 6.1 的低 PE 若伴随 forward EPS 下修——印证「低 PE = 周期顶」（2017-18 周期 MU forward PE 仅 4-5x、随后跌 56%）	估值陷阱	●
4	三星 HBM4 放量 + 各家 2024-25 扩产产能于 2026-27 集中释放，缺口收敛快于认证周期	供给洪水	●
5	超大厂 AI capex 季度环比转弱——内存唯一主驱动失速，强周期股回撤最猛	需求	●
6	LTA 的 price floor 被触发或被重谈——印证三家对 2028 后供给松动的内部预期成真	周期	●
7	中国 CXMT/长鑫在标准 DRAM/DDR4-5 产能爬坡超预期，稀释标准 DRAM（非 HBM）定价权	竞争	●
8	RMBS HBM4E 控制器 IP 渗透不及预期（base die 设计权被原厂自留）——补涨逻辑落空	卡位落空	●

## 十、行动清单

- **现在买/重点观察：**RMBS——卡位硬、相对未透支，是本报告倾向的最纯补涨；回调建仓优于追高。
- **持有不追：**MU / 海力士——真瓶颈、盈利真实，但 +1,000% 后只在回调加仓，不新建追高。
- **只监控不买：**HBF（SNDK+海力士，● 待验证）· MRVL/ALAB 的 CXL/custom HBM 远期期权——等 2027 兑现信号。
- **绝不追：**SNDK（+5,348%，低基数透支最深）· WDC（+1,172%，涨幅领先盈利）。
- **下次看哪 5 个数据：**① 3Q26 DRAM 合约价 QoQ（二阶导是否继续转负）② 2027 HBM 长协重定价倍数 ③ RMBS HBM4E 控制器 IP 签约客户数 ④ 超大厂季度 capex 环比 ⑤ NAND 现货价见顶时点。
- **哪个信号出现要重写结论：**DRAM 涨价 3Q26 转平 + 超大厂 capex 环比转弱同时出现 = 周期顶确认，全组从「持有」降「减仓」。

## 十一、来源置信度表

结论/数字	来源	日期	口径	置信度	冲突来源
现价/PE/52w (全部标的)	yfinance 实时取价	2026-06-21	收盘/TTM	A	—
美光 FY26Q2 营收 \$23.86B / 毛利率 74.9% / DRAM \$18.8B	美光官方季报/IR	2026-Q2	GAAP·季度	A	—
海力士 2026Q1 营收 ₩52.58 万亿 (首破 50 万亿)	海力士官方季报	2026-Q1	自然季·韩元	A	—
常规 DRAM 合约价 1Q26 约 +90%、2Q26 +58~63%	TrendForce/Omdia	2026	合约·QoQ	B	区间口径差 +90~98%
DRAM 收入市占 三星 38.6%/海力士28.8%/美光22.4%	Omdia/TrendForce/Counterpoint	2026Q1	收入口径	B	三源一致
HBM4 份额预期 海力士 60~70%/三星25~30%/美光约20%	多机构	2026	NVIDIA HBM4 供应商口径	C	UBS 给海力士约70%
海力士「营业利润率 72%/净利率77%」、三星「DS 营业利润 ₩53.7 万亿 YoY +48~49x」	二手汇编	2026	量级存疑 (净利率>营业利润率反常)	D	待官方季报坐实, 本报告不采用绝对值
SOCAMM 2027 满足 NVIDIA 需求约 60%	单一机构	2026	单源	D	仅作方向, 未采用精确数

## 十二、数字三道关自评

- 量级一致性:** 美光单季营收 \$23.86B < FY3Q26 指引 \$33.5B (单季 ≤ 后续指引, 方向自洽); 海力士 2026Q1 营收 ₩52.58 万亿「首破 50 万亿」与「QoQ +60%」自洽。三星 DRAM 营收 \$37.4B 与全行业 +85.3% YoY 量级一致。三星「DS 营业利润 ₩53.7 万亿」因量级超全公司历史峰值数倍、且「净利率 77% > 营业利润率 72%」违反量级一致性, 判为口径错置, 仅采用「半导体利润同比数十倍量级、方向确定」, 不采用争议绝对值。

- **单位显式化**：美光市值 \$1,278.8B = 约 1.28 万亿美元；RMBS 市值 \$15.3B = 153 亿美元；海力士现价 ₩2,764,000 为韩元单股价，非美元，避免与美元标的混算。DRAM 涨价 +90% 为 QoQ 百分比，非绝对价。
- **≥2 源走公告**：现价走 yfinance 实时 (A)；美光/海力士财务走公司官方季报 (A)；DRAM 涨价与市占走 TrendForce/Omdia/Counterpoint 多源交叉 (B)；利润率绝对值因单源且量级存疑，已隔离进来源置信度表 D 级、正文不采用。

### 十三、免责声明

本报告由涌现资本产业研究部基于公开资料与行业数据独立撰写，所有现价、PE 及 52 周涨幅截至 2026-06-21，采用实时行情口径。报告中财务数据来源于各公司官方季报、IR 披露及 TrendForce/Omdia/Counterpoint 等行业研究机构，关键数字已做多源交叉与量级一致性核对；部分利润率/利润绝对值因量级存疑已隔离进来源置信度表 D 级、正文不予采用。本报告所含方向性评级（● 利好/受益 · ● 中性 · ● 承压/风险 · ● 待验证）为基于产业逻辑的独立判断，不构成任何证券买卖要约或投资建议。市场有风险，强周期板块波动剧烈，投资者应独立决策并自负盈亏。本报告版权归涌现资本所有，未经授权不得转载。

## 附录

## A1. 完整受益标的名单（9 标的）

#	代码	现价	PE	52w 涨幅	卡点定位	评级
1	RMBS	\$141.17	67.2	+140.0%	内存接口 IP, HBM4E 控制器 +MRDIMM 双引擎	🟢 布局观察
2	MU	\$1,133.99	53.5	+996.9%	HBM 核心, 美股唯一纯正原厂	🟡 持有不追
3	海力士 000660.KS	₩2,764,000	6.7	+1,028.2%	HBM 全球第一, MR-MUF 壁垒	🟡 持有不追
4	三星 005930.KS	₩354,000	6.1	+514.6%	HBM4 追赶者, 份额回升弹性	🟡 中性
5	MRVL	\$310.58	106.4	+405.5%	定制 HBM 基底 + 定制 ASIC	🟡 远期期权
6	ALAB	\$417.07	285.7	+391.9%	内存互连 CXL/PCIe	🟡 高赔率高估值
7	SNDK (闪迪)	\$2,184.75	74.6	+5,348.3%	NAND/企业级 SSD, HBF 早期卡位 (含 2024 分拆/低基数)	🔴 追高区
8	WDC (西部数据)	\$746.23	44.6	+1,172.1%	近线 HDD 纯化 (含分拆/低基数成因)	🔴 追高区
9	STX (希捷)	\$1,070.23	102.0	+717.5%	近线 HDD 龙头	🟡 中性

(TSMC \$462.12 / PE 39.7: HBM4 base die 逻辑代工受益方, 作为传导链一环列示, 非纯内存标的。)

## A2. 最近一季财务明细

- 美光 FY26 Q2 (截至 2026-02-26): 营收 \$23.86B (YoY +196%, QoQ +75%), 毛利率 74.9% (公司纪录), DRAM 收入 \$18.8B (占 79%)。FY3Q26 指引: 营收 \$33.5B±0.75, 毛利率约 81%。2026 HBM 产能全部售罄。
- 海力士 2026 Q1 (自然季): 营收 ₩52.58 万亿 (QoQ +60%, YoY +198%), 首破 50 万亿创历史新高。
- RMBS Q1 FY26: 总营收 \$180.2M (产品 \$88.0M, YoY +15%), 双重收入结构 (IP 授权+版税 / 物理接口芯片), 80% 级毛利。
- MRVL Q1 FY27: 营收 \$2.418B (YoY +28%), 数据中心 \$1.83B (占 76%)。
- ALAB Q1 FY26: 营收 \$308.4M (YoY +93%)。